

**性能特点：**

- 频带：1-12GHz
- 噪声系数：1.4dB
- 增益：18dB
- 输入/输出回波损耗：15dB/10dB
- 单电源供电：+5V@58mA
- 芯片尺寸：2.64mm×1.64mm×0.1mm

**产品简介：**

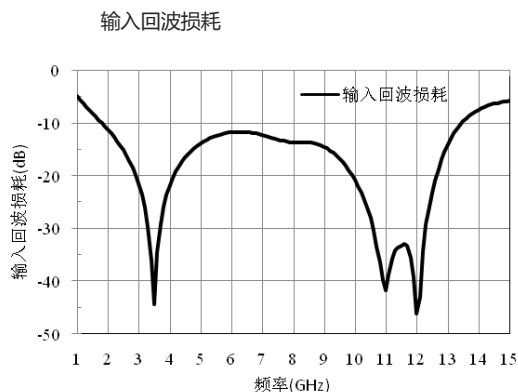
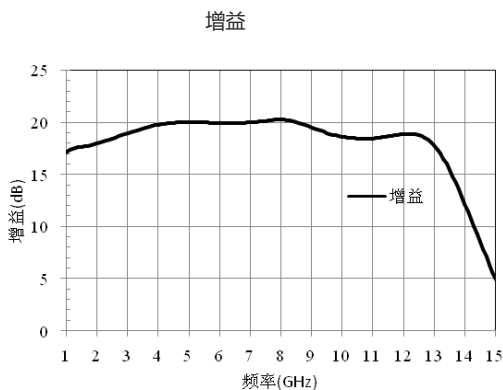
HH-LN444-G 是一款 GaAs MMIC 超宽带低噪声放大芯片，其频率范围覆盖 1-12GHz，整个带内噪声系数典型值为 1.4dB。HH-LN444-G 采用 +5V 供电。

**电参数：** (  $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ,  $V_D=+5\text{V}$  )

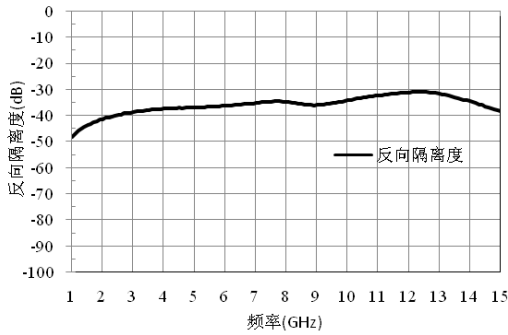
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	1~12			GHz
噪声系数	-	1.4	-	dB
增益	-	18	-	dB
输入回波损耗	-	15	-	dB
输出回波损耗	-	10	-	dB

**使用限制参数：** (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

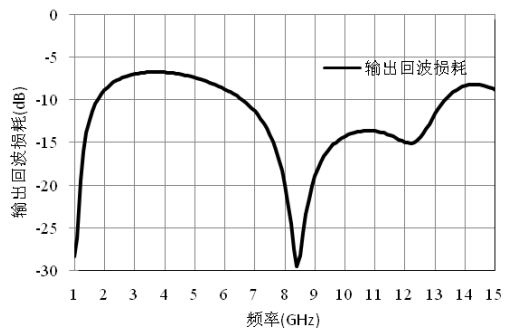
输入功率	+23dBm
控制电压	+9V
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~125°C

**典型曲线：**

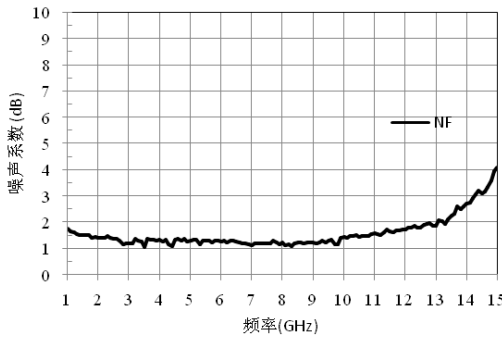
反向隔离度



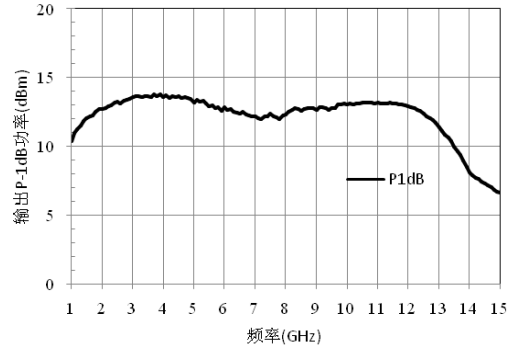
输出回波损耗



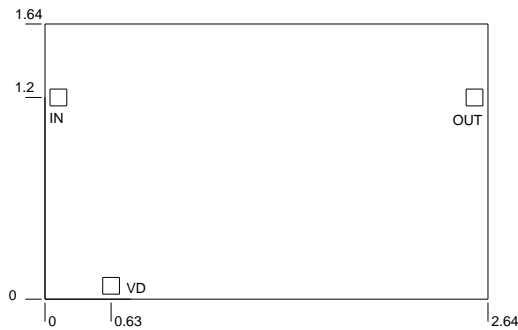
噪声系数



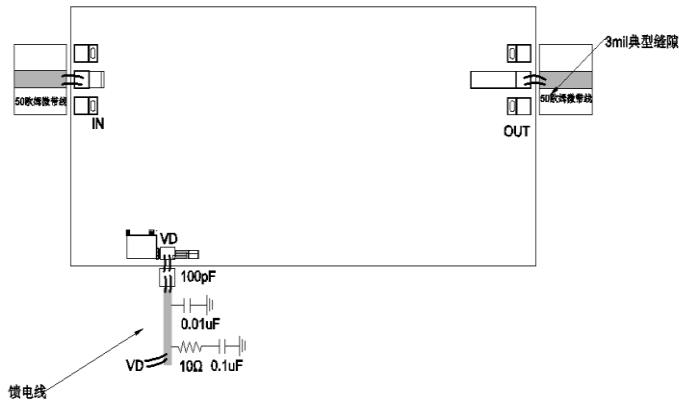
输出 P-1dB 功率



尺寸图：(单位 mm)



## 建议装配图：



## 使用说明：

**注意事项：**输入输出有隔直电容

**存储：**芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

**清洁处理：**裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

**静电防护：**请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

**常规操作：**拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

**装架操作：**芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

**键合操作：**输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。